

パワーデバイスの特性測定や高絶縁材料の特性評価に最適！

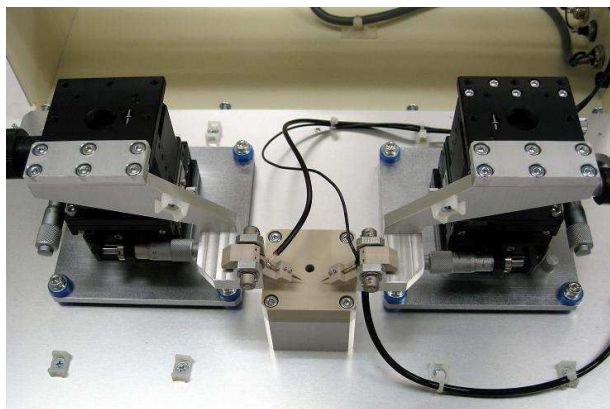
主な特長

- ◆ 6インチφのデバイスに最高3kVを印加しI-V特性を測定します。5pAレベル(代表値)の電流測定が可能になります。
- ◆ FET特性の測定(半導体パラメータアナライザ機能)やFET信頼試験(TDDDB試験)など半導体パラメータの測定に最適です。
- ◆ カーブトレーサでは測定できないパワーデバイスの特性評価(ブレイクダウン測定)がpAの精度で測定可能です。
- ◆ 任意の電圧印加モードでの測定およびエージング試験に対応します。
- ◆ デバイスに合わせた治具の製作にも対応可能です。



標準仕様 (下記標準外の仕様にもお応え致しますので、ご相談ください)

サンプルサイズ	最大6インチφの基板
サンプルステージ	固定
サンプル温度制御	オプション
サンプル固定	真空チャックによる吸着
サンプル観察	オプション
サンプルプローブ	3軸(X-Y-Z) マニュアルプローバ×4台 直径12μ mφ のタングステンピン
プローバ筐体	電気シールドおよび遮光
最高印加電圧	3000V DC
抵抗測定範囲	~10 ¹⁶ Ω
測定システム	アジレント製 半導体パラメータ・アナライザ B1505 A B1513A



最高印加電圧±3kVのアジレント製B1505Aに接続することにより、最高3kVを印加して微小電流を測定します。高電圧モジュールB1513Aにより、不連続な変化や瞬間的な高電圧を発生させることなく、0～3kVの範囲でシームレスに電圧を変化させます。

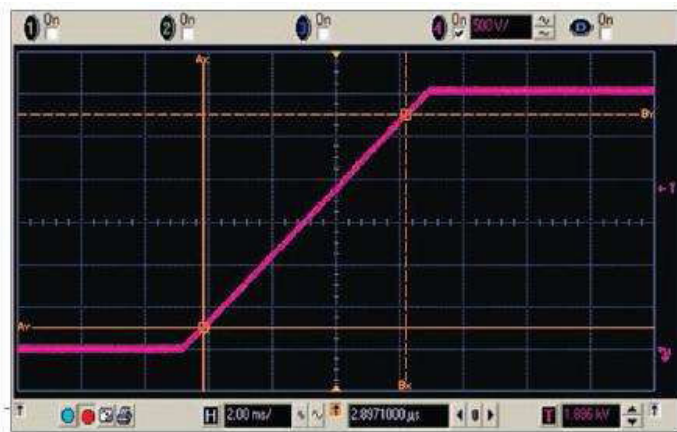
サンプルステージやプローバ支持台には超高抵抗の材質を採用し、pAレベルの微小電流の測定を可能にしました。2端子測定または4端子測定に対応します。

プローバ筐体は電気シールドと遮光を兼ねています。インターロック機構により、サンプル交換やプローバ調整のためカバーを開けた時には高電圧出力を停止します。オプションでサンプル観察窓や実体顕微鏡を設けることもできます。



I-V特性評価 アジレント製 半導体パラメータ・アナライザ B1505A B1513A(モジュール)

高電圧用SMUIは、数秒で μA レベルから3000 Vまで掃引できます。これによりデバイス評価を迅速におこなえます。



モジュール	HPSMU (B1510A)	HVSMU (B1513A)
最大出力電圧	± 200 V	± 3000 V
最大出力電流	± 1 A at ± 20 V	± 8 mA at ± 1500 V ± 4 mA at ± 3000 V
電圧測定分解能	2 μV	200 μV
電流測定分解能	10 fA	10 fA

注) B1512A大電流40Aモジュール用には別のフィクスチャーがございます。

記載の仕様はお断りなく変更することがあります。 (2009.12)

製造元

アクシス・ネット株式会社

本社
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 204
TEL: 06-4806-8570 FAX: 06-4806-8572
URL: <http://www.axisnetinc.com>

東日本オフィス
TEL: 048-611-6502